

Schottky Diode Gen ²

$$V_{RRM} = 150V$$

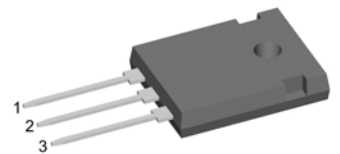
$$I_{FAV} = 2 \times 35A$$

$$V_F = 0.77V$$

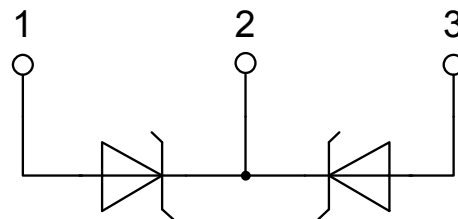
High Performance Schottky Diode
Low Loss and Soft Recovery
Common Cathode

Part number

DSA70C150HB



Backside: cathode



Features / Advantages:

- Very low V_f
- Extremely low switching losses
- Low I_{rm} values
- Improved thermal behaviour
- High reliability circuit operation
- Low voltage peaks for reduced protection circuits
- Low noise switching

Applications:

- Rectifiers in switch mode power supplies (SMPS)
- Free wheeling diode in low voltage converters

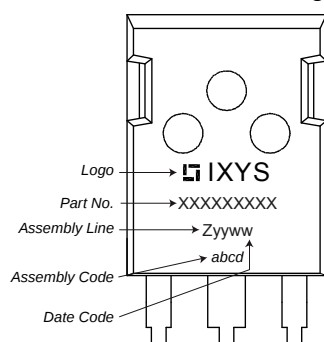
Package: TO-247

- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0

Schottky				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions		min.	typ.	max.	Unit
V_{RSM}	max. non-repetitive reverse blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$				150	V
V_{RRM}	max. repetitive reverse blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$				150	V
I_R	reverse current, drain current	$V_R = 150\text{ V}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			680	μA
		$V_R = 150\text{ V}$	$T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$			7.5	mA
V_F	forward voltage drop	$I_F = 35\text{ A}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			0.90	V
		$I_F = 70\text{ A}$				1.06	V
		$I_F = 35\text{ A}$	$T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$			0.77	V
		$I_F = 70\text{ A}$				0.94	V
I_{FAV}	average forward current	$T_C = 150^{\circ}\text{C}$ rectangular $d = 0.5$	$T_{VJ} = 175^{\circ}\text{C}$			35	A
V_{F0}	threshold voltage	} for power loss calculation only		$T_{VJ} = 175^{\circ}\text{C}$		0.53	V
r_F	slope resistance					4.9	m Ω
R_{thJC}	thermal resistance junction to case					0.7	K/W
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink				0.25		K/W
P_{tot}	total power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$				215	W
I_{FSM}	max. forward surge current	$t = 10\text{ ms}; (50\text{ Hz}), \text{ sine}; V_R = 0\text{ V}$	$T_{VJ} = 45^{\circ}\text{C}$			600	A
C_J	junction capacitance	$V_R = 24\text{ V}$ $f = 1\text{ MHz}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		226		pF

Package TO-247			Ratings			
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
I_{RMS}	RMS current	per terminal ¹⁾			50	A
T_{VJ}	virtual junction temperature		-55		175	°C
T_{op}	operation temperature		-55		150	°C
T_{stg}	storage temperature		-55		150	°C
Weight				6		g
M_D	mounting torque		0.8		1.2	Nm
F_C	mounting force with clip		20		120	N

Product Marking



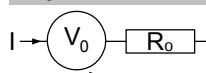
Part number

D = Diode
 S = Schottky Diode
 A = low VF
 70 = Current Rating [A]
 C = Common Cathode
 150 = Reverse Voltage [V]
 HB = TO-247AD (3)

Ordering	Part Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	DSA70C150HB	DSA70C150HB	Tube	30	506708

Equivalent Circuits for Simulation

* on die level

 $T_{VJ} = 175^{\circ}\text{C}$ 

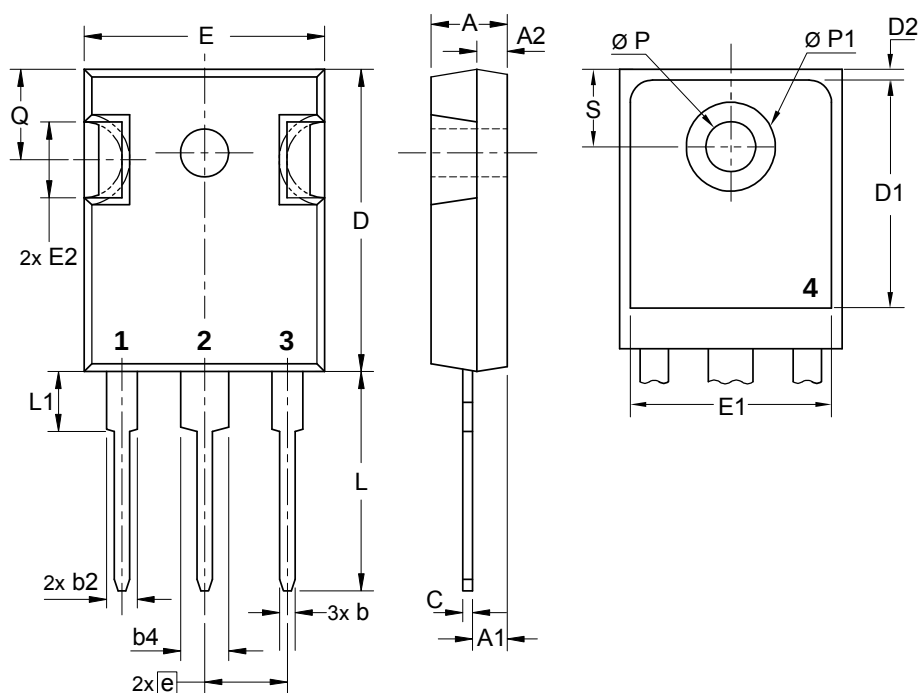
Schottky

 $V_{0\max}$ threshold voltage 0.53

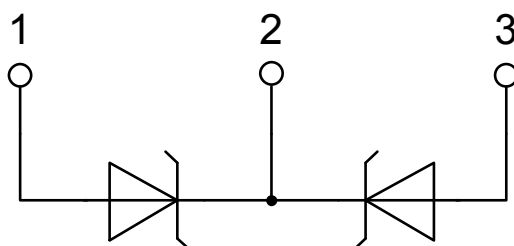
V

 $R_{0\max}$ slope resistance * 2.3

mΩ

Outlines TO-247


Sym.	Inches		Millimeter	
	min.	max.	min.	max.
A	0.185	0.209	4.70	5.30
A1	0.087	0.102	2.21	2.59
A2	0.059	0.098	1.50	2.49
D	0.819	0.845	20.79	21.45
E	0.610	0.640	15.48	16.24
E2	0.170	0.216	4.31	5.48
e	0.215	BSC	5.46	BSC
L	0.780	0.800	19.80	20.30
L1	-	0.177	-	4.49
Ø P	0.140	0.144	3.55	3.65
Q	0.212	0.244	5.38	6.19
S	0.242	BSC	6.14	BSC
b	0.039	0.055	0.99	1.40
b2	0.065	0.094	1.65	2.39
b4	0.102	0.135	2.59	3.43
c	0.015	0.035	0.38	0.89
D1	0.515	-	13.07	-
D2	0.020	0.053	0.51	1.35
E1	0.530	-	13.45	-
Ø P1	-	0.29	-	7.39



Schottky

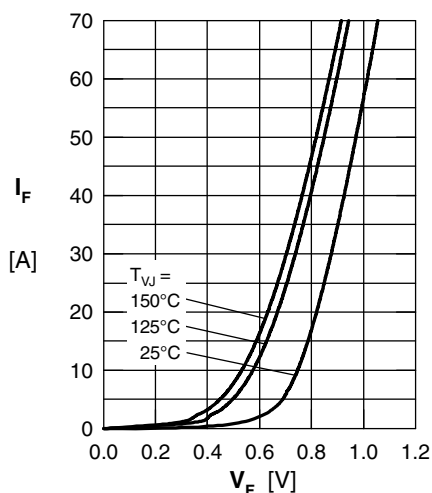


Fig. 1 Maximum forward voltage drop characteristics

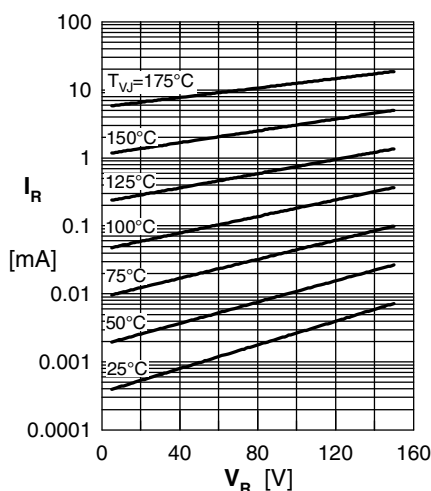


Fig. 2 Typ. reverse current I_R vs. reverse voltage V_R

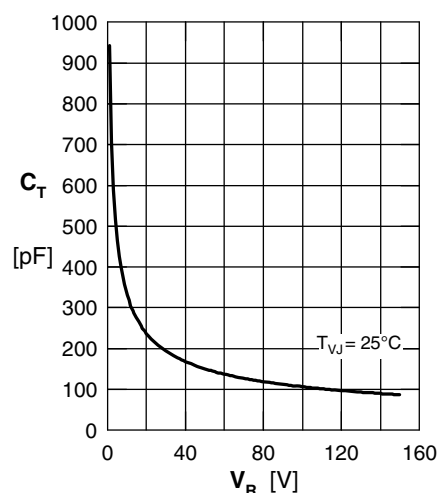


Fig. 3 Typ. junction capacitance C_T vs. reverse voltage V_R

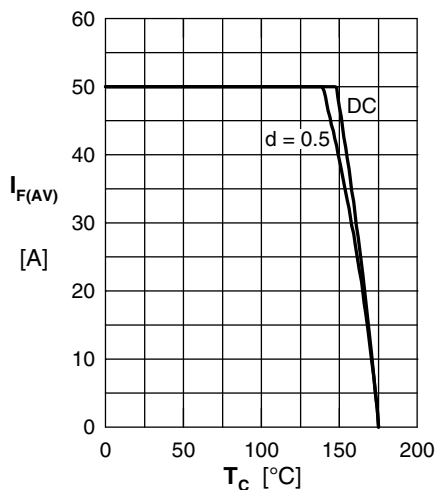


Fig. 4 Average forward current $I_{F(AV)}$ vs. case temperature T_C

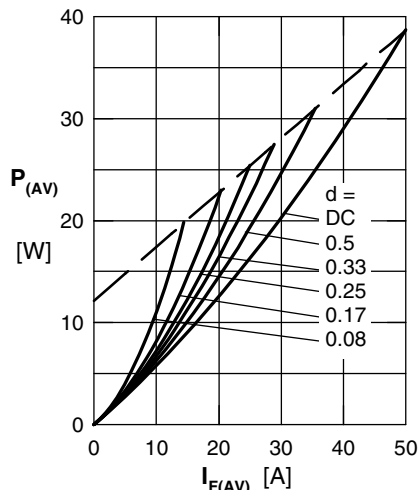


Fig. 5 Forward power loss characteristics

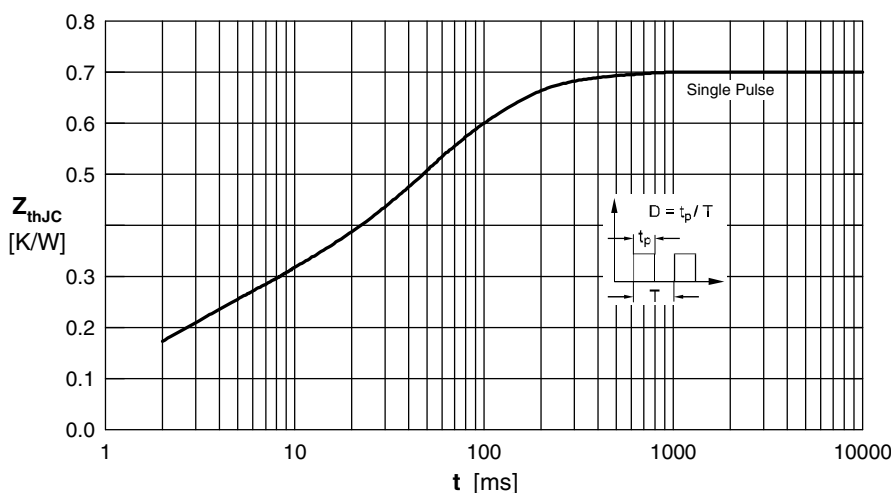


Fig. 6 Transient thermal impedance junction to case at various duty cycles

Note: All curves are per diode

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9